

项目名称： 面向三维集成的氧化物半导体基 DRAM， 编号：8201701924， 用途：在中国科学院半导体研究所集成技术中心做电子束曝光、PECVD 薄膜沉积等加工服务。北京大学委托中国科学院半导体研究所集成技术中心进行工艺服务，主要制备及表征面向三维集成的氧化物半导体基 DRAM，需要用到如电子束曝光、PECVD 薄膜沉积、ICP 干法刻蚀、IBD 薄膜沉积等设备以完成图案定义、介质沉积、金属刻蚀等工艺。

中国科学院半导体研究所集成技术中心的电子束光刻系统 Jeol 8100FS EBL 精度高，理论极限可到 8 nm；ICP 干法刻蚀系统 SI 500 可以完成 Al、Ni、Cr、Cu、HfO₂、SiO₂ 等各种金属及介质材料的刻蚀。同时其它工艺相关设备齐全，有完成整套 DRAM 制备及表征的能力。综合比较后中国科学院半导体研究所集成技术中心符合本次技术服务条件、另外所收取的费用以及合同中的相关服务条款也较合理。综上本次服务选择中国科学院半导体研究所集成技术中心完成。

课题负责人（签字）：